

2SK2633LS

NチャンネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用

暫定規格

- 特長
- ・低オン抵抗。
 - ・低 Q_g 化。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / $T_a = 25^\circ\text{C}$

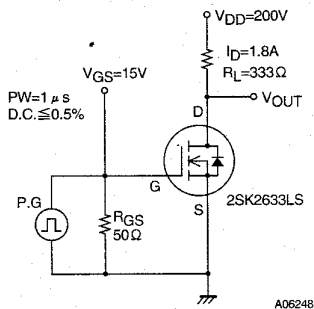
			unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DSS}	800	V
ゲート・ソース電圧	V_{GSS}	± 30	V
ドレイン電流 (DC)	I_D	3	A
ドレイン電流 (パルス)	I_{DP}	9	A
許容損失	P_D	30	W
チャンネル温度	T_{ch}	150	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

$T_c = 25^\circ\text{C}$

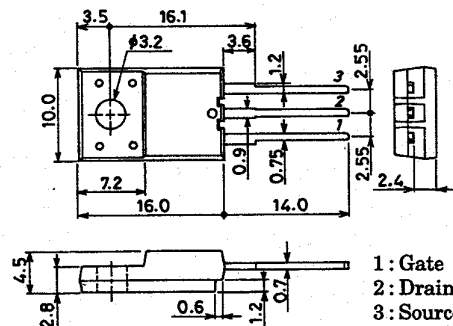
電気的特性 Electrical Characteristics / $T_a = 25^\circ\text{C}$

		min	typ	max	unit
ゲート・ソース降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 1\text{mA}, V_{GS} = 0$	800		V
ドレイン・ソースしゃ断電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 800\text{V}, V_{GS} = 0$		1.0	mA
ゲート・ソースもれ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30\text{V}, V_{DS} = 0$		± 100	nA
カットオフ電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 1\text{mA}$	3.5	5.5	V
順伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 1.8\text{A}$	0.9	1.8	S
飽和抵抗	$R_{DS(on)}$	$I_D = 1.8\text{A}, V_{GS} = 15\text{V}$		2.8	Ω
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 20\text{V}, f = 1\text{MHz}$		700	pF
出力容量	C_{oss}	$V_{DS} = 20\text{V}, f = 1\text{MHz}$		180	pF
帰還容量	C_{rss}	$V_{DS} = 20\text{V}, f = 1\text{MHz}$		100	pF
ゲート入力電荷量	Q_g	$V_{DS} = 200\text{V}, I_D = 3\text{A}$ $V_{GS} = 10\text{V}$		20	nC
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$	下図指定回路において		20	ns
立上り時間	t_r	"		20	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$	"		50	ns
下降時間	t_f	"		25	ns
ダイオード順電圧	V_{SD}	$I_S = 3\text{A}, V_{GS} = 0$		1.2	V

スイッチングタイム測定回路図



外形図 2078B
(unit: mm)



- 1: Gate
- 2: Drain
- 3: Source

SANYO: TO-220FI(LS)

本製品は開発中です。
詳細については営業担当者にご連絡ください。